

3DG2219 (2N2219) 型 NPN 硅高频小功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值	单位
极 限 值	P _{CM}	T _A =25℃	800	mW
	I _{CM}		800	mA
	T _{jm}		150	℃
	T _{stg}		-55~150	℃
	V _{(BR)CBO}	I _{CB} =10μA	≥75	V
	V _{(BR)CEO}	I _{CE} =10mA	≥40	V
	V _{(BR)EBO}	I _{EB} =10μA	≥6.0	V
	I _{CBO}	V _{CB} =60V	≤10	nA
	I _{EBO}	V _{CB} =3.0V	≤10	nA
	V _{CEsat}	I _C =0.5A I _B =0.05A	≤1.0	V
	h _{FE}	V _{CE} =10V I _C =0.15A	100~300	
交 流 参	f _T	I _C =50mA V _{CE} =10V f=20MHz	≤250	MHz
外 引 线 说 明	 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极 A3-02B(B4)			
替代型号：2N2219A				